Ar/C₂H₂ 混合ガスジェットプラズマ CVD 法を用いた

超高速 DLC 成膜と膜質分析

Ultra High-Rate Deposition and Film Quality Analysis of DLC Films Using Gas-Jet Plasma CVD Method with Ar/C₂H₂ Mixed Gas 豊橋技科大¹、オーエスジー²、岡山工技³

大浦 曜¹, 長田直人¹, 坂東隆宏¹, 滝川浩史¹, 針谷 達¹, 権田英修², 國次真輔³

Toyohashi Univ. Technol.¹, OSG Coating Service Co., Ltd.², Ind. Technol. Cent. Okayama Pref.³ Hikaru Ohhra¹, Naoto Nagata¹, Takahiro Bando¹, Hirofumi Takikawa¹, Toru Harigai¹, Hidenobu Gonda², Shinsuke Kunitsugu³ E-mail: ohhra.hikaru.bs@tut.jp

1. はじめに

非晶質炭素膜であるダイヤモンドライクカ ーボン (Diamond-like carbon: DLC) 膜は, その 優れた機械的特性から切削工具のコーティン グに利用され, 被覆物の耐久性を高める¹⁾。 DLC の成膜速度は,約 10~数 100 nm/min^{2.3)}で, 生産性向上のために数 μ m/min 程度の高速成膜 が必要となる。

我々は、Ar プラズマジェットの中心から同 軸で C₂H₂をジェット状に供給する同軸ガス供 給プラズマジェット CVD 法を開発し、成膜速 度 2.3 μm/min およびナノインデンテーション 硬さ 17 GPa の DLC 膜を得た。本研究では、 Ar ガスと C₂H₂ガスを同じガスジェットノズル から混合した状態で供給し、DLC を成膜する。 Ar/C₂H₂ 混合ガスジェットプラズマ CVD 法を 用いた DLC 成膜における、ガス流量に対する 成膜速度と膜質の関係を明らかにする。

2. 実験方法

Ar ガスと, 炭素源となる $C_{2}H_2$ ガスを同じガ スジェットノズルから供給した。DC パルス電 源 (アルバック, DPG-5P)を用いて,電圧-500 V,周波数 40 kHz, パルス幅 24.6 µs の DC 負 パルス電圧をステージに印加した。Ar 流量は 250~2000 sccm, C_2H_2 流量は 250~1000 sccm の間で 250 sccm ずつ変化させた。プロセス圧 力は,約 100 Pa 前後でガス流量に依存した。 基板には Si を用い,成膜時間は 0.5 min とした。 膜質はラマンスペクトルから判断した。

3. 結果と考察

Ar 流量 1000 sccm と C_2H_2 流量 500 sccm を同 じジェットノズルから供給することで,2.2 μ m/min の高速成膜を得た。また,ラマンスペ クトル形状は,同軸ガス供給プラズマジェット CVD 法と大きな違いは見られなかった。

Ar 流量と C₂H₂ 流量を変更し成膜した DLC 膜のラマンスペクトルから膜質の分析を行った。同軸ガス供給プラズマジェット CVD 法で 得た硬さ 17 GPaを持つDLC 膜のラマンスペク



Fig. 1. (a) I_D/I_G ratio and (b) G-peak position of DLC films for Ar and C₂H₂ flow rate.

トルを基準とし、ラマンスペクトルの傾きや、 1360 cm⁻¹ 付近に現れるショルダーピークの形 状から、作製した DLC 膜を 3 つに分類した。 ラマンスペクトルの波形分離分析から得た *I*_D/*I*_G比と G ピーク位置から、3 つの分類におけ るしきい値を明確にした。Fig. 1 に示す *I*_D/*I*_G 比と G ピーク位置の範囲内の両方を満たすと き、同軸ガス供給プラズマジェット CVD 法で 作製した DLC 膜と近い膜質を持ち、DLC 膜と して必要な硬さを有することが示唆された。

謝辞 本研究の一部は,大澤科学技術振興財団の支援 を受けて行われた。

参考文献

A.F. Yetim, *et al.*: Diam. Relat. Mater. 120 (2021) 108639.
T. Imai, *et al.*: Vacuum 167 (2019) 536.

3) J. Heeg, et al.: Vacuum 83 (2008) 712.